

XIII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA
MATERIA CONDENSADA

CAXAMBU, 8 a 12 de maio de 1990

SEM/10:50/6*E. MULTI- δ - DOPING Si : GaAs, CRESCIDO POR EPITAXIA POR FEIXE MOLECULAR
(MRE) - P. Basmajli, A. C. Notari, M. Siu Li, L. Ioriatti, O. Hipólito, E. Ranz* e J. C. Port-
tal* (IFQSC/USP - 13560 - São Carlos - SP).

As propriedades de magnetotransporte do gas de elétrons bidimensional (2-deg) do mul-
ti- δ -doped Si:GaAs, crescido por MBE, foram caracterizadas a baixa temperatura (4,2 K) como
função da pressão hidrostática. A amostra multi-delta foi crescida sob um substrato de GaAs,
orientado (100) com temperatura e taxa de crescimento da ordem de 500° C e 0,4 $\mu\text{m/h}$ respecti-
vamente.

As oscilações de Shubnikov-de-Haas (5. d. H) mostram a presença evidente de duas sub-
bandas, e sob luz mostra também um aumento da concentração de portadores dentro da sub-ban-
da. A densidade de portadores foi analisada por transformação de Fourier. De mais, um modelo
teórico foi usado para a comparação dos resultados experimentais.

* CNRS-INS- F. 31077 TOULOUSE e CNRS-SNCI- F. 38042 GRENOBLE.

p.226

40108 03 4

00001362

Campo	Dado
*****	Documento 1 de 1
No. Registro	000804172
Tipo de material	TRABALHO DE EVENTO-RESUMO - NACIONAL
Entrada Principal	Basmaji, Pierre
Título	Multi - 'DELTA' - doping 'SI' : 'GA"AS', crescido por epitaxia por feixe molecular (mbe).
Imprensa	São Paulo : Sbf, 1990.
Descrição	p.226.
Assunto	SEMICONDUCTORES
Autor Secundário	Notari, A C (*)
Autor Secundário	Siu Li, Máximo
Autor Secundário	Ioriatti Júnior, Lidério Citrângulo
Autor Secundário	Hipólito, Oscar
Autor Secundário	Ranz, E (*)
Autor Secundário	Portal, J C (*)
Autor Secundário	Encontro Nacional de Física da Materia Condensada (13. 1990 Caxambu)
Fonte	Programa e Resumos, São Paulo : Sbf, 1990
Unidade USP	IFQSC-F -- INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Unidade USP	IFQSC-F -- INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Unidade USP	IFQSC-F -- INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Unidade USP	IFQSC-F -- INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Localização	IFSC PROD001362